

当前位置: 科技部门户 > 新闻中心 > 科技动态 > 国内外科技动态

【字体: 大 中 小】

### 俄科学家发现改进磁传感器方法

日期: 2018年03月15日 来源: 科技部

俄罗斯科学院发布消息称,其西伯利亚分院克拉斯诺亚尔斯克科学中心(联邦研究中心)基连斯基物理研究所的科学家首次发现,由金属(铁磁体)、氧化物和硅衬底(半导体)组成的混合结构具有高磁阻值,该结构的电阻可随光学效应发生改变,并可通过磁场来控制电压。该效应的本质是混合结构中的电子在移动时,对磁场更为敏感。利用这一特性,可制造具有特定磁导率的材料,研制出由磁场控制的电子设备,并扩展现有磁传感器性能。

此外,据研究专家介绍,这种基于半导体形成的混合结构与现代电子产品的工艺基础——CMOS技术(互补金属氧化物半导体)完全兼容。日前,俄科学家正在继续研究混合结构以及其它成分和组态的导电性。

打印本页

关闭窗口



版权所有: 中华人民共和国科学技术部  
地址: 北京市复兴路乙15号 | 邮编: 100862 | 地理位置图 | ICP备案号: 京ICP备05022684